

## CIRCUITOS ELECTRÓNICOS II - 66.10 DISEÑO DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS - 86.10

# Trabajo práctico final

## Diseño y construcción de un amplificador clase G - mediciones

Alumnos:

LUNA Diego
Padrón N° 75451
Ing. BERTUCCIO José Alberto
diegorluna@gmail.com
Ing. MARCHI Edgardo
NEUMARKT FERNÁNDEZ Leonardo
Padrón N° 97471
Ing. BULACIO Matías
leoneu928@gmail.com
Ing. D'ANGIOLO Federico
RIZZO Gonzalo Gabriel
Padrón N° 96772
Ing. GAMEZ Pablo
gonzalorizzo95@gmail.com

12 de Diciembre de 2019

#### Circuitos electrónicos II - 66.10 Diseño de circuitos electrónicos - 86.10

Trabajo práctico final

## Índice

Ín	dice	]
1.	Consideraciones previas al diseño	1
	1.1. Objetivo y requerimientos de usuario	1
	1.2. Especificaciones	1
	1.2.1. Acerca de la máxima potencia	1
	1.2.2. Acerca de la máxima excursión	2
	1.2.3. Acerca del slew-rate	2
2.	Observaciones y conclusiones	3
3.	Bibliografía	5
$\mathbf{A}_{]}$	péndices	7
$\mathbf{A}$	. Hojas de datos	7
	A.1. MPSA42/MMBTA42	7
	A.2. MPSA92/MMBTA92	7
	A.3. MJE340	7
	A.4. MJE350	7
	A.5. MMPQ6700	8
	A.6. 2SC5200	8
	A.7. 2SA1943	8
	A.8. NE5532	8
	A.9. Metal film resistor	8
	A.10.Carbon film resistor	ć
	A.11.Ceramic capacitor	Ś
	A.12. Electrolitic Aluminum capacitor	S



## Índice de figuras



## Índice de cuadros





## 1. Consideraciones previas al diseño

#### 1.1. Objetivo y requerimientos de usuario

Nuestro objetivo es armar un circuito amplificador que amplifique una señal de audio que será reproducida en un Bafle (asumimos respuesta resistiva pura en todo el ancho de banda). Debe proveer al usuario con una buena calidad de sonido (algo subjetivo, no obstante acá solo se consideran medidas reales) con volumen alto, sin consumir mucha más energía de la necesaria, ni ser muy grande y pesado. Es decir, debe tener baja distorsión (THD), alta relación señal-ruido (SNR), eficiencia razonable y buena potencia máxima de salida.

#### 1.2. Especificaciones

• Máxima Potencia de Salida:  $>= 60 \text{W} RMS@8\Omega$ 

• Salida clase G

• THD: <0.01%@1kHz, <0.02%@10kHz , a 60WRMS@8 $\Omega$  y 1WRMS@8 $\Omega$ 

• Slew-Rate:  $> 15 \frac{V}{\mu S}$ 

• Impedancia de entrada:  $> 30 \mathrm{k}\Omega$ 

• Sensibilidad: 1,1V pico @8 $\Omega$ 

 $\bullet\,$  Ancho de banda: 10Hz  $\longrightarrow$  30kHz

• Factor de amortiguamiento: > 200

• Ancho de banda de potencia: > 30kHz

• Alimentación:

• Baja tensión: ±15V nominal (desde transformador de 12V + 12V), ripple máximo 10%

 $\bullet$  Alta tensión:  $\pm 49 \mathrm{V}$  nominal (desde transformador de 36 V + 36 V), ripple máximo 10% desde transformador de 36 V + 36 V), ripple máximo 10% desde transformador de 36 V + 36 V), ripple máximo 10% desde transformador de 36 V + 36 V), ripple máximo 10% desde transformador de 36 V + 36 V), ripple máximo 10% desde transformador de 36 V + 36 V), ripple máximo 10% desde transformador de 36 V + 36 V), ripple máximo 10% desde transformador de 36 V + 36 V), ripple máximo 10% desde transformador de 36 V + 36 V), ripple máximo 10% desde transformador de 36 V + 36 V), ripple máximo 10% desde transformador de 36 V + 36 V), ripple máximo 10% desde transformador de 36 V + 36 V), ripple máximo 10% desde transformador de 36 V + 36 V), ripple máximo 10% desde transformador de 36 V + 36 V), ripple máximo 10% desde transformador de 36 V + 36 V), ripple máximo 10% desde transformador de 36 V + 36

• Máxima excursión: 31V

#### 1.2.1. Acerca de la máxima potencia

Nuestro diseño es efectivamente el de un amplificador de 100W RMS, sin embargo no lo caracterizamos para esa potencia, ya que la fuente de alimentación diseñada no nos permite alcanzar esa potencia, sin embargo, sin modificar el circuito, con una fuente de alimentación adecuada, posiblemente switching (mejorando mucho la eficiencia global), se puede alcanzar esta potencia, seguramente sea necesario también agrandar el disipador de los transistores de potencia, el principal motivo de limitar la potencia es económico, ya que el precio de la fuente de alimentación termina dominando el precio total del diseño.



#### 1.2.2. Acerca de la máxima excursión

Para una salida senoidal de 60W RMS, su potencia pico es  $\frac{V_{max}^2}{R_L} = 120$ W que, con carga  $R_L = 8\Omega$  da una tensión pico de  $V_{max} \cong 31$ V. A esta tensión se llega cuando la entrada es la sensibilidad especificada, 1,1V $pico@8\Omega$ . Estos 31V serán la máxima excursión, la tensión máxima en la que el amplificador garantiza que no haya recortes bajo cualquier condición de alimentación, ya que al no ser regulada la fuente de alimentación, se consideró el peor caso, con la tensión de línea a 80% de su valor nominal, esto se detalla en la sección sobre la fuente de alimentación.

#### 1.2.3. Acerca del slew-rate

El slew rate especificado  $\left(15\frac{V}{\mu s}\right)$  mas que duplica el valor mínimo para cumplir las otras especificaciones: el mayor ritmo de crecimiento para señales de ancho de banda 30kHz y máxima excursión 31V se da cuando la senoide cruza por cero, y su pendiente es  $2\pi \times 30$ kHz  $\times 31$ V  $\cong 5.8 \frac{V}{\mu s}$ .



## 2. Observaciones y conclusiones



## 3. Bibliografía

### Referencias

[1] Analysis and Design of Analog Integrated Circuits (3<sup>rd</sup> Edition)

Author: Paul R. Gray Author: Robert G. Meyer

Publisher: John Wiley & Sons, Inc.; 3<sup>rd</sup> Edition (Janury 15, 1993)

Copyright: © 1993, John Wiley & Sons, Inc.

ISBN 10: 0471574953

Website: Analysis and Design of Analog Integrated Circuits (3<sup>rd</sup> Edition)

[2] Analysis and Design of Analog Integrated Circuits (4<sup>th</sup> Edition)

Author: Paul R. Gray Author: Paul J. Hurst Author: Stephen H. Lewis Author: Robert G. Meyer

Publisher: John Wiley & Sons, Inc.; 4<sup>th</sup> Edition (2001)

Copyright:  $\bigodot$  2001, John Wiley & Sons, Inc.

ISBN 10: 0471321680 ISBN 13: 9780471321682

Website: Analysis and Design of Analog Integrated Circuits (4<sup>th</sup> Edition)

[3] Analysis and Design of Analog Integrated Circuits (5<sup>th</sup> Edition)

Author: Paul R. Gray Author: Paul J. Hurst Author: Stephen H. Lewis Author: Robert G. Meyer

Publisher: John Wiley & Sons, Inc.; 5<sup>th</sup> Edition (2009)

Copyright: © 2001, John Wiley & Sons, Inc.

ISBN 10: 0470245999 ISBN 13: 9780470245996

Website: Analysis and Design of Analog Integrated Circuits ( $5^{
m th}$  Edition)

[4] Circuitos microelectrónicos (4<sup>ta</sup> Edición) español

Author: Adel. S. Sedra Author: Kenneth C. Smith

Publisher: Oxford, University press; 4<sup>ta</sup> Edición (2001) Copyright: © 1999, Oxford, University press México.

Original Copyright: © 1998, 1991, 1987, 1982, Oxford, University press Inc.

ISBN 10: 01951166310

Website: Circuitos microelectrónicos (4<sup>ta</sup> Edición) español

#### [5] Microelectronic circuits (5<sup>th</sup> Edition)

Author: Adel. S. Sedra Author: Kenneth C. Smith

Publisher: Oxford, University press; 5<sup>th</sup> Edition (2004)

Copyright:  $\bigodot$  2004, 1998, 1991, 1987, 1982, Oxford, University press Inc.

ISBN 10: 0195142527

Website: Microelectronic circuits (5<sup>th</sup> Edition)

## [6] AUDIO POWER AMPLIFIER DESIGN HANDBOOK (5th Edition)

Author: Douglas Self

Publisher: Elsevier Ltd; 5<sup>th</sup> Edition (2009)

Copyright: © 2009, Douglas Self. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

ISBN 13: 9780240521626

Website: AUDIO POWER AMPLIFIER DESIGN HANDBOOK (5<sup>th</sup> Edition)



## **Apéndices**

## A. Hojas de datos

#### A.1. MPSA42/MMBTA42

#### MPSA42

NPN Bipolar Small Signal Transistor

Manufacturer page: https://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MPSA42

Manufacturer Datasheet: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MPSA42-D.PDF

### A.2. MPSA92/MMBTA92

#### MPSA92

PNP Bipolar Small Signal Transistor

Manufacturer page: https://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MPSA92

Manufacturer Datasheet: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MPSA92-D.PDF

#### A.3. MJE340

#### **MJE340**

Medium Power NPN Bipolar Power Transistor

Manufacturer page: https://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MJE340

Manufacturer Datasheet: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJE340-D.PDF

#### A.4. MJE350

#### **MJE350**

Medium Power PNP Bipolar Power Transistor

 $Manufacturer\ page:\ https://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MJE350$ 

Manufacturer Datasheet: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJE350-D.PDF

1<sup>er</sup> c. 2019



### A.5. MMPQ6700

#### TIP41

Quad Complementary Pair Transistor

Manufacturer page: https://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MMPQ6700

Manufacturer Datasheet: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMPQ6700-D.PDF

#### A.6. 2SC5200

#### 2SC5200

Power transistor for high-speed switching applications

Manufacturer page: 2SC5200

Manufacturer Datasheet: 2SC5200

#### A.7. 2SA1943

### 2SA 1943

Power transistor for high-speed switching applications

Manufacturer page: 2SA1943

Manufacturer Datasheet: 2SA1943

#### A.8. NE5532

#### NE5532

Dual Low-Noise High-Speed Audio Operational Amplifier

Manufacturer page: NE5532

 $Manufacturer\ Datasheet:\ http://www.ti.com/lit/gpn/NE5532$ 

#### A.9. Metal film resistor

Metal film resistor

Metal film resistor

Manufacturer page: https://www.vishay.com/resistors-fixed/metal-film/tab/doclibrary/

#### A.10. Carbon film resistor

#### Carbon film resistor

Carbon film resistor

Manufacturer page: http://www.vishay.com/resistors-fixed/carbon-film/tab/doclibrary/

### A.11. Ceramic capacitor

#### Ceramic capacitor

Ceramic disk capacitor

Manufacturer page: https://www.vishay.com/capacitors/ceramic/disc/

### A.12. Electrolitic Aluminum capacitor

#### $Electrolitic\ capacitor$

Electrolitic aluminum capacitor

Manufacturer page: https://www.vishay.com/capacitors/aluminum/